НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни <u>Ел</u>	Електронна компонентна база радіоелектронної апаратури					
на тему: Вимірюв	<u>овач індуктивності на 555 таймері</u>					
		Студента II курсу групи ДК-92				
		Напряму підготовки: Телекоммунікації та				
		радіотехніка				
		<u>Лазарчук Д. Р.</u>				
		(прізвище та ініціали)				
		Керівник:				
		доцент, к.т.н. Короткий Є.В.				
		(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)				
		Національна оцінка:				
		Кількість балів: Оцінка: ECTS				
Члени комісії:		доцент, к.т.н. Короткий Є.В.				
члени комісії.	(rimma)	<u> </u>				
	(підпис)	(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)				
-						
	(підпис)	(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)				

Зміст

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розроблювальний прилад буде призначений для вимірювання індуктивності досліджуваного зразка і може використовуватися для вимірювання індуктивності невідомої котушки. Мета виготовити прилад(чи доповнення) за допомогою якого можна буде оцінити здатність зразка накопичувати магнітну енергію, в процесі розробки та створення якого ознайомитись та дослідити ці процеси. Наприклад, ознайомитись з Altium Designer в якому будемо розробляти схему та плату приладу де буде потрібна бібліотека компонентів, з Fusion 360 де буде створюватися 3д модель компоненту. Створимо план роботи. Для початку розберемося як можна виміряти індуктивність та який спосіб нам більше підходить, виберемо принципову схему та проаналізуємо $\ddot{i}i$ — це буде перший розділ. Далі визначимо які струми та напруги протікають між вузлами нашої схеми – другий розділ. З визначених та відомими нами параметрами виберемо компоненти нашого пристрою – третій розділ. Для візуального оцінювання плати не погано б створити 3д модель цієї плати, Altium Designer допоможе з цим але йому потрібні 3д моделі компонентів то ж створимо 3д модель компоненту в Fusion 360 — четвертий розділ. Потрібно буде створити друковану плату та згенерувати необхідні файли для виготовлення її – п'ятий розділ.

Перший розділ

Мені відомі декілька способів вимірювання індуктивності:

- I. Завдяки ЕРС самоїндукції величина якого пропорційна індуктивності зразка та швидкості зміни струму що проходить через нього: $\varepsilon = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$
- II. Утворити коливальний контур з зразка та відомої ємності тоді частота власних коливань складатиме $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L*C}}$, яка будуть залежить тільки від котушки якщо не буде змінюватися конденсатор.
- III. За допомогою запасеної енергії $W = \frac{LI^2}{2}$

Я обрав таку схему(Рис.1.1):

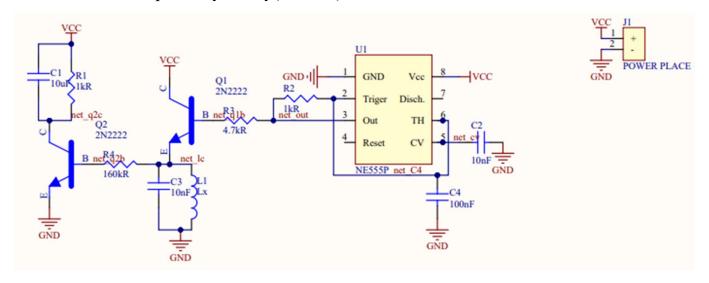
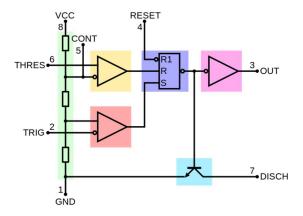


Рис. 1.1

Принцип роботи: мікросхема NE555 з деякими елементами (R2, C2, C4) генерує прямокутні імпульси робочий цикл яких приблизно 50%, принцип генерації опишемо нижче, далі імпульси підсилюються на транзисторі Q1 з нього вони потрапляють на коливальний контур складений з L1 та C3 коливання якого теж підсилюються і потрапляють на RC-контур складений з C1 та R1 на якій перетворюються в постійну напругу та струм, так як C1 та C3 постійні вихідна напруга залежати тільки від індуктивності досліджуваного зразка.

Детальніше розглянемо роботу генератора на Рис. 1.2 блок-схема мікросхеми NE555 його головної частини.



Вивід ОUТ це вихід нашого таймеру на ньому можливі два сигнали низький(вихід підтягнуто до землі) та високий(вихід підтягнуто до Vcc).

Вивід TRIG(на схемі позначений як Triger) коли на ньому напруга становить менше 1/3 Vcc на виводі OUT буде генеруватися високий сигнал поки на ньому не буде більше 1/3 Vcc та на виводі THRES не буде більше 2/3 Vcc.

Вивід THRES(на схемі позначений як TH) буде генеруватися низький сигнал поки на ньому буде більше 2/3 Vcc. TRIG має більший пріоритет за THRES. Так як виводи THRES та TRIG замкнені та через конденсатор C4 підєднані до землі, а через резистор R2 до OUT то при напрузі конденсатора менше 1/3 Vcc буде високий сигнал на виході де через резистор буде заряджатись конденсатор поки на ньому не стане напруга більше 2/3 Vcc при ній на виході буде встановлений низький сигнал і через той самий резистор конденсатор буде розряджатись. Міняючи опір у резистора та ємність конденсатора можно буде змінювати частоту. Визначимо час заряду-розряду конденсатора з формули.

$$U_C(t) = Vcc(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Видно що 2/3 Усс буде при

$$e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{3} = > -\frac{t}{RC} = \ln 3^{-1} = > t_{0-\frac{2}{3}} = RC * \ln 3$$

Но цей час щоб зарядитись від 0 до 2/3 Vcc це буде тільки при вімкнені схеми щоб дізнатися за скільки він зарядиться від 1/3 до 2/3 віднімемо час зарядки від 0 до 1/3

$$e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{2}{3} = > -\frac{t}{RC} = \ln 2 - \ln 3 = > t_{0-\frac{1}{3}} = RC * (\ln 3 - \ln 2) = > t_{\frac{1}{3}-\frac{2}{3}} = RC * \ln 3 - RC * (\ln 3 - \ln 2) = RC * \ln 2$$

В нашій схемі конденсатор емністю 100н Φ = 10^{-7} Φ і резистор опором 1кOм= 10^3 Oм

$$t_{\frac{1}{3}-\frac{2}{3}} = 10^{-7} * 10^3 * \ln 2 = 10^{-6} * 69,3 \text{ (c)} = 69,3 \text{ (MKC)}$$

Тобто тривалість високого або низького рівня всього 69,3 мкс(збігается з симуляцією) що дає частоту приблизно 7,2 кГц.

Другий розділ

В першому розділі було наведено принцип роботи генератора з якого ясно, що максимальна напруга на конденсаторі C4 складатиме 2/3 Vcc, і з блок-схеми Рис. 1.2 видно що конденсатор С2 під'єднаний до внутрішнього подільника напруги тож на ньому буде теж 2/3 Vcc. Через резистор R2 максимальний струм буде протікати тоді коли конденсатор С4 повністю розряджений або заряджений тому на ньому падіння напруги складатиме максимум Vсс і з законна Oма U = I * R можна сказати що максимальний струм складатиме Vcc/1000 – порядку міліампер. Через резистор R3(який обмежує струм бази транзистора Q1) та R4(який обмежує струм бази транзистора Q2) за допомогою симуляції схеми в LTspice було визначено, що максимальна напруга на них майже Vcc, а тому максимальний струм буде Vcc/4700 для транзистора Q1 i Vcc/160000 для транзистора Q2. З даташита на транзистор Q1 та Q2 був знайдено коефіцієнт в максимальне значення якого складає 300 тож максимальний можливий струм колектора з формули $I_c = \beta * I_b$ становитиме Vcc/15,6 для транзистора Q1 і Vcc/533,3 для транзистора Q2. Так як максимальний струм резистора R1 обмежаний струмом колектора транзитора Q2 то візмим його як максимально можливий. Всі значення наведені в Таблиці 1. Також важно зазначити що для транзисторів взяті значно вищі показники такі як коефіцієнт В та падіння напруги 0.7В.

Таблиця 1

Струми та напруги в схемі

Vcc	5	В
d	10%	
В	300	

	I		•	U		W			
	min	typ.	max	min	typ.	max	min	typ.	max
R1	4,50E- 03	5,00E- 03	5,50E- 03	4,5	5	5,5	0,020	0,025	0,030
R2	4,50E- 03	5,00E- 03	5,50E- 03	4,5	5	5,5	0,020	0,025	0,030
R3	9,57E- 04	1,06E- 03	1,17E- 03	4,5	5	5,5	0,004	0,005	0,006
R4	2,81E- 05	3,13E- 05	3,44E- 05	4,5	5	5,5	0,000	0,000	0,000
Q1	0,287	0,319	0,351	0,7	0,7	0,7	0,201	0,223	0,246
Q2	0,008	0,009	0,010	0,7	0,7	0,7	0,006	0,007	0,007
C1				4,5	5	5,5			
C2				3	3,3	3,7			
С3				4,5	5	5,5			
C4				3	3,3	3,7			

Третій розділ

При виборі компонентів керувався такими вимогам:

- Відповідність номіналів вибраних елементів до номіналів на схеми.
- Запас мінімум 30%. Наприклад напруга на конденсаторі повинна бути мінімум на 30% вища за робочу чи розсіювана потужність на елементі повинна складати не більше 70% від максимально допустимої.
- Компонент повинен виконувати свої функції на робочих частотах.
- Компонент повинен бути в наявності.

Взявши до уваги вишем перераховане, а також данні з Таблиці 1 були такі компоненти: резистори smd 0805 с точністю ±1% та максимальною потужністю 1/8 Вт, конденсатори smd 0805 с максимальною напругою від 16В невідомої точності, в якості NE555 була NE555Р яка має PDIP корпус та робочий діапазон температур від 0 до 70 С, транзистори вибрав smd аналог 2N2222. Максимальна частота роботи схеми приблизно 15 кГц, максимальна частота роботи транзистора 300 МГц що явно

вище десь на 3 порядку. Резистори з такою потужністю будуть нагружені приблизно на 25%.

Була створена бібліотека компонентів. Процес додавання компоненту до неї проходив в такій послідовності: імпорт з digikey.com властивостей елементу, створення позначення на схемі за допомогою примітивів, зміна імені та задавання позначення в якості коментаря номінал елемента.

Посилання на ВОМ файл з аналогічними елементами основані на digikey.com: https://github.com/Lazar4uk/Analog-electronic/blob/main/curs/Bill%20of%20Materials-Analog%20electronic.xlsx

Четвертий розділ

Для створення моделі були виконані такі кроки:

- 1. Створення паралепітеду з розмірами довжина 9.5, ширина 6.4 та висота 4.5
- 2. Створення горизонтальних виступів контактів 8 штук по 4 с двох сторін рівномірно розподілені відносно центру с шагом 2.54 з розмірами довжина 0.8, ширина 1.4 та висота 0.3
- 3. На кінці виступів створення вертикально розташованих з розмірами довжина 0.3, ширина 1.4 та висота 1.95 і на кінці ще один з розмірами довжина 0.3, ширина 0.25 та висота 3.
- 4. За допомогою Fillet були згладжени края на виводах
- 5. За допомогою Chamfer були зрізані края на корпусі
- 6. І за допомогою Hole був створений ключ.

Посилання на модель: https://github.com/Lazar4uk/Analog-electronic/blob/main/curs/3d models/dip8%20v3.step

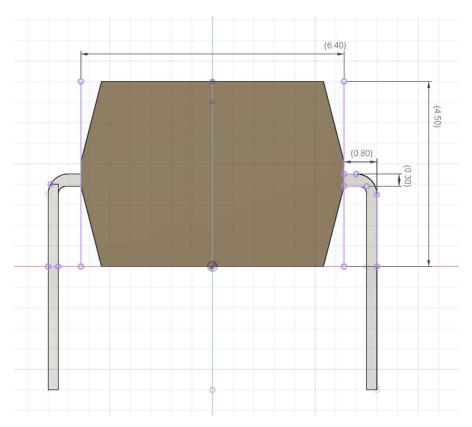


Рис. 4.1



Рис. 4.2

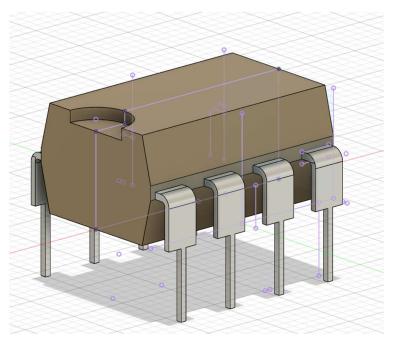


Рис. 4.3

П'ятий розділ